

(19) 日本国特許庁(JP)

再 公 表 特 許(A1)

(11) 国際公開番号  
WO2008/056643

発行日 平成22年2月25日 (2010. 2. 25)

(43) 国際公開日 平成20年5月15日 (2008. 5. 15)

(51) Int. Cl.	F 1	テーマコード (参考)
A 6 1 B 8/00 (2006.01)	A 6 1 B 8/00	4 C 6 0 1
H 0 4 R 17/00 (2006.01)	H 0 4 R 17/00 3 3 0 G	5 D 0 1 9

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 23 頁)

出願番号	特願2008-543071 (P2008-543071)	(71) 出願人	000153498 株式会社日立メディコ 東京都千代田区外神田四丁目14番1号
(21) 国際出願番号	PCT/JP2007/071516	(72) 発明者	佐野 秀造 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 株式会社日立メディコ内
(22) 国際出願日	平成19年11月6日 (2007. 11. 6)	(72) 発明者	佐光 暁史 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 株式会社日立メディコ内
(31) 優先権主張番号	特願2006-302627 (P2006-302627)	(72) 発明者	小林 隆 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 株式会社日立メディコ内
(32) 優先日	平成18年11月8日 (2006. 11. 8)	(72) 発明者	泉 美喜雄 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 株式会社日立メディコ内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		

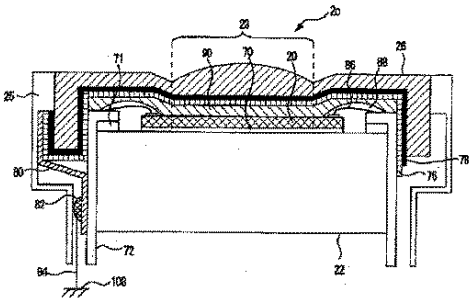
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 超音波探触子及びこれを用いた超音波診断装置

(57) 【要約】

バイアス電圧に応じて電気機械結合係数または感度が変化する複数の振動要素を有し超音波を送受波するcMUTチップと、前記cMUTチップの上方に設けられる音響レンズと、前記cMUTチップの下方に設けられるバックিং層とを備える超音波探触子において、

前記音響レンズの超音波送受信面側あるいは前記音響レンズと前記cMUTチップの間に、電気漏洩防止手段が備えられている。電気漏洩防止手段は、例えば絶縁層であり、例えばグラウンド層である。このような構造の超音波探触子により、超音波探触子から被検体への電気漏洩を防止し、電気的安全性を向上させた超音波探触子及びこれを用いた超音波診断装置を提供することができる。



**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

バイアス電圧に応じて電気機械結合係数または感度に変化する複数の振動要素を有し超音波を送受波する cMUT チップと、前記 cMUT チップの上方に設けられる音響レンズと、前記 cMUT チップの下方に設けられるバッキング層とを備える超音波探触子において、

前記音響レンズの超音波送受信面側あるいは前記音響レンズと前記 cMUT チップの間に、cMUT チップ内の電極から被検体へ電気が漏洩するのを防止するための電気漏洩防止手段が備えられていることを特徴とする超音波探触子。

**【請求項 2】**

請求項 1 記載の超音波探触子において、

10

前記電気漏洩防止手段は、少なくとも一層の絶縁層であることを特徴とする超音波探触子。

**【請求項 3】**

請求項 1 記載の超音波探触子において、

前記電気漏洩防止手段は、前記音響レンズと前記 cMUT チップの間に配置された少なくとも一層のグランド層であることを特徴とする超音波探触子。

**【請求項 4】**

請求項 3 記載の超音波探触子において、

前記グランド層と前記 cMUT チップ内部に備えられた電極との間に介在層が備えられていることを特徴とする超音波探触子。

20

**【請求項 5】**

請求項 4 記載の超音波探触子において、

前記介在層は、電気を導通しない材質から成る絶縁層であり、前記グランド層と前記 cMUT チップの間に備えられていることを特徴とする超音波探触子。

**【請求項 6】**

請求項 4 記載の超音波探触子において、

前記介在層は、前記 cMUT チップの一部であり、前記電極の前記超音波送受信面側に備えられていることを特徴とする超音波探触子。

**【請求項 7】**

請求項 6 記載の超音波探触子において、

30

前記介在層は膜体であることを特徴とする超音波探触子。

**【請求項 8】**

請求項 2 記載の超音波探触子において、

前記絶縁層が前記音響レンズの超音波送受信面に備えられていることを特徴とする超音波探触子。

**【請求項 9】**

請求項 2 記載の超音波探触子において、

前記絶縁層が前記音響レンズの前記被検体側と反対側の面に沿って備えられていることを特徴とする超音波探触子。

**【請求項 10】**

40

請求項 2 記載の超音波探触子において、

前記絶縁層が前記 cMUT チップの前記被検体側の面に備えられていることを特徴とする超音波探触子。

**【請求項 11】**

請求項 2 記載の超音波探触子において、

少なくとも 1 層のグランド層が、前記絶縁層の前記被検体側と反対側に備えられていることを特徴とする超音波探触子。

**【請求項 12】**

請求項 3 記載の超音波探触子において、

前記バッキング層の上面周縁から四方側面に渡ってフレキシブル基板が備えられ、前記

50

グラウンド層が、前記フレキシブル基板の外部側面に固定された導電材及びグラウンド線を介してグラウンドに接続されていることを特徴とする超音波探触子。

【請求項 1 3】

請求項3記載の超音波探触子において、

前記バッキング層の上面周縁から四方側面に渡って配置されたフレキシブル基板と、前記超音波探触子の四方側面に配置された超音波探触子カバーが備えられ、

前記グラウンド層が、前記超音波探触子カバーの内部側面に固定された導電材及びグラウンド線を介してグラウンドに接続されていることを特徴とする超音波探触子。

【請求項 1 4】

請求項 1 記載の超音波探触子において、

10

前記電気漏洩防止手段は、前記音響レンズと前記cMUTチップの間に配置され、該電気漏洩防止手段は、1層のグラウンド層と、それを挟んで配置された2層の絶縁層より構成されていることを特徴とする超音波探触子。

【請求項 1 5】

請求項14記載の超音波探触子において、

前記2層の絶縁層少なくとも1層の一部が、前記複数の振動素子の前記被検体側に対応する部分の少なくとも一部において、設けられていないことを特徴とする超音波探触子。

【請求項 1 6】

請求項2記載の超音波探触子において、

前記絶縁層はシリコン酸化物膜あるいはパラキシリレン膜であることを特徴とする超音波探触子。

20

【請求項 1 7】

請求項3記載の超音波探触子において、

前記グラウンド層はCu膜であることを特徴とする超音波探触子。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0 0 0 1】

本発明は、超音波探触子及びこれを用いた超音波診断装置に関し、特に、被検体に対する電氣的安全性を向上させた超音波探触子及びこれを用いた超音波診断装置に関する。

【背景技術】

30

【0 0 0 2】

超音波診断装置は、超音波探触子から出力されるエコー信号とその反射信号に基づいて診断画像を撮像する装置である。超音波探触子には、複数の超音波振動子が配列される。超音波振動子は、駆動信号を超音波に変換して超音波を被検体に送波すると共に、被検体から発生した反射エコー信号を受波して電気信号に変換する。

【0 0 0 3】

近年、cMUT(Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer)を用いた超音波探触子が開発されている。cMUTは、半導体微細加工プロセスにより製造される超微細容量型超音波振動子であり、例えば特許文献1に開示されているようなものである。cMUTでは、超音波送受信面に平行な方向に複数対相対して配置された2つの電極(被検体側とバッキング層側)にバイアス電圧を印加するとともに、駆動信号を重畳して印加し、超音波を発信する。

40

。

【0 0 0 4】

【特許文献 1】 米国特許5894452号公報。

【特許文献 2】 特開2007-235795号公報。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0 0 0 5】

しかしながら、本発明者らは、上記従来技術を検討した結果以下の問題点に気がついた。

。

50

すなわち、従来のPZTを用いた超音波探触子では超音波送受信面に相対して配置された電極間に1種類の駆動信号を電圧として印加するのみであり、例えば特許文献2記載のように被検体側に配置された電極にグランド電極を接触して、電極から被検体の方へ流れる電流を低減することができた。しかし、cMUTを用いた超音波探触子では、主に前記バイアス電圧をバッキング層側の電極に印加するとともに、高周波から成る駆動信号(駆動電圧)を被検体側の電極に印加するため、グランド層を直接被検体側の電極に接触させることができなく、グランド層を設けられなければ、絶縁構造が不十分となる。

また、cMUTを用いた超音波探触子では、音響整合層を設けない場合があるが、その場合にも絶縁構造の劣化が問題となる。

【0006】

10

本発明の目的は、cMUTを用いた超音波探触子において、好適な絶縁構造を施すことにより被検体への電気漏洩を防止し、電気的安全性を向上させた超音波探触子及びこれを用いた超音波診断装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明によれば、バイアス電圧に応じて電気機械結合係数または感度に変化する複数の振動要素を有し超音波を送受波するcMUTチップと、前記cMUTチップの上方に設けられる音響レンズと、前記cMUTチップの下方に設けられるバッキング層とを備える超音波探触子において、

前記音響レンズの超音波送受信面側あるいは前記音響レンズと前記cMUTチップの間に、  
電気漏洩防止手段が備えられていることを特徴とする超音波探触子が提供される。

20

【発明の効果】

【0008】

本発明によれば、cMUTを用いた超音波探触子において、好適な絶縁構造を施すことにより被検体への電気漏洩を防止し、電気的安全性を向上させた超音波探触子及びこれを用いた超音波診断装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】 本発明に係る超音波診断装置の構成図。

【図2】 本発明に係る超音波探触子の構成図。

30

【図3】 本発明に係る振動子の構成図。

【図4】 図3における振動要素一個を側面から見た構成図。

【図5】 実施例1に係る超音波探触子を示す図。

【図6】 超音波探触子の配線を示す図。

【図7】 実施例2に係る超音波探触子を示す図。

【図8】 実施例3に係る超音波探触子を示す図。

【図9】 実施例4に係る超音波探触子を示す図。

【図10】 導電構造及び絶縁構造を示す模式図。

【図11】 実施例5に係る超音波探触子を示す図。

【図12】 実施例6に係る超音波探触子を示す図。

40

【図13】 実施例7に係る超音波探触子を示す図。

【図14】 実施例8に係る超音波探触子を示す図。

【図15】 実施例9に係る超音波探触子を示す図。

【符号の説明】

【0010】

2c 超音波探触子、20 cMUTチップ、22 バッキング層、23 超音波が射出される領域、25 超音波探触子カバー、26 音響レンズ、70、71 接着層、72 フレキシブル基板、76 導電膜、78 絶縁膜、80 導電材、82 接続部、84 グランド線、86 ワイヤ、88 ワイヤ封止樹脂、90 接着層、108 グランド

【発明を実施するための最良の形態】

50

## 【0011】

以下添付図面を参照しながら、本発明に係る超音波探触子及びこれを用いた超音波診断装置の好適な実施形態について詳細に説明する。尚、以下の説明及び添付図面において、略同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略することにする。

## 【0012】

最初に、図1を参照しながら、超音波診断装置1の構成について説明する。

図1は、超音波診断装置1の構成図である。

## 【0013】

本発明に係る超音波診断装置1は、超音波探触子2と、送信手段3と、バイアス手段4と、  
受信手段5と、整相加算手段6と、画像処理手段7と、表示手段8と、制御手段9と、操作手  
段10とから構成される。

10

## 【0014】

超音波探触子2は、被検体に接触させて被検体との間で超音波を送受波するものである。  
超音波探触子2から超音波が被検体に射出され、被検体から発生した反射エコー信号が  
超音波探触子2により受波される。

## 【0015】

送信手段3及びバイアス手段4は、超音波探触子2内に相対して配置された電極にバイア  
ス電圧を印加するとともに、駆動信号を重畳して印加し、超音波を発信するためのもので  
ある。

20

## 【0016】

受信手段5は、超音波探触子2への反射エコー信号を受信するものである。

受信手段5は、さらに、受信した反射エコー信号に対してアナログデジタル変換等の処  
理も行う。

## 【0017】

整相加算手段6は、受信された反射エコー信号を整相加算する装置である。

画像処理手段7は、整相加算された反射エコー信号に基づいて診断画像(例えば、断層像  
や血流像)を生成する装置である。

## 【0018】

表示手段8は、画像処理手段7で生成された診断画像を表示する表示装置である。

30

## 【0019】

制御手段9は、上述した各構成要素を制御する装置である。

## 【0020】

操作手段10は、制御手段9に例えば、診断開始の合図等の指示を与える装置である。操  
作手段10は、例えば、トラックボールやキーボードやマウス等の入力機器である。

## 【0021】

次に、図2～図4を参照しながら、超音波探触子2について説明する。

## 【0022】

図2は、超音波探触子2の構成図である。図2は、超音波探触子2の一部切り欠き斜視図で  
ある。ただし、図の向かって上側が被検体に接触され、超音波が送信される方向である。

40

## 【0023】

超音波探触子2は、cMUTチップ20を備える。cMUTチップ20は、複数の振動子21-1、振動  
子21-2、・・・が短冊状に配列された1次元アレイ型の振動子群である。振動子21-1、振  
動子21-2、・・・には、複数の振動要素28が配設される。尚、図2で示されたものはリニ  
ア型探触子であるが、2次元アレイ型やコンベックス型等の他の形態の振動子群を用いて  
もよい。

## 【0024】

cMUTチップ20の背面側(図の向かって下側)には、バッキング層22が設けられる。cMUTチ  
ップ20の超音波射出側には、音響レンズ26が設けられる。cMUTチップ20及びバッキング層  
22などは、超音波探触子カバー25に格納される。

50

## 【0025】

cMUTチップ20では、バイアス手段4によるバイアス電圧が印加の基に、送信手段3からの駆動信号が超音波に変換され、変換された超音波は被検体に送波される。

## 【0026】

受信手段5は、被検体から発生した超音波を電気信号に変換して反射エコー信号として受波する。

## 【0027】

バッキング層22は、cMUTチップ20から背面側に射出される超音波の伝搬を吸収して、余分な振動を抑制するための層である。

## 【0028】

音響レンズ26は、cMUTチップ20から送波される超音波ビームを収束させるレンズである。音響レンズ26は、所望の焦点距離に基づいて曲率が定められる。

10

## 【0029】

尚、音響レンズ26とcMUTチップ20との間にマッチング層を設けてもよい。マッチング層は、cMUTチップ20及び被検体の音響インピーダンスを整合させて、超音波の伝送効率を向上させる層である。

## 【0030】

図3は、図2における振動子21の構成図である。

## 【0031】

振動子21-1、21-2、・・・を構成する複数の振動要素28の被検体側には、上部電極46-1、46-2、・・・が配置され、長軸方向Xに複数個に分割されて振動子21毎に結線される。すなわち、上部電極46-1、上部電極46-2・・・は、長軸方向Xに並列配置される。

## 【0032】

振動子21を構成する複数の振動要素28の被検体と反対側には下部電極(48-1~48-4)が配置され、短軸方向Yに複数個(図3では4列)に分割されて結線される。すなわち、下部電極48-1、下部電極48-2、下部電極48-3、・・・は、短軸方向Yに並列配置される。

## 【0033】

図4は、図3における振動要素28一個を側面から見た構成図(断面図)である。

## 【0034】

振動要素28は、基板40、膜体44、膜体45、上部電極46、枠体47、下部電極48から構成される。振動要素28は、半導体プロセスによる微細加工により形成される。尚、振動要素28は、cMUTの1素子分に相当する。

30

## 【0035】

基板40は、シリコン等の半導体基板であり、下部電極側に配置されている。

## 【0036】

膜体44及び枠体47は、シリコン化合物等の半導体化合物から形成される。膜体44は、振動要素28の最も被検体側(超音波射出側)に設けられ、枠体47は膜体44の背面(被検体側と反対側)に配置される。膜体44と枠体47との間に上部電極46が設けられる。枠体47と基板40の間には膜体45が設けられ、その内部に下部電極48が設けられる。枠体47及び膜体45により区画された内部空間50は、真空状態とされるか、あるいは、所定のガスが充填される。

40

## 【0037】

上部電極46及び下部電極48は、それぞれ、駆動信号としての交流高周波電圧を供給する送信手段3と、バイアス電圧として直流電圧を印加するバイアス手段4とに接続される。

## 【0038】

超音波を送波する場合には、振動要素28の上部電極46及び下部電極48に、直流のバイアス電圧( $V_a$ )が印加され、バイアス電圧( $V_a$ )により電界が発生する。発生した電界により膜体44に張力が発生して所定の電気機械結合係数( $S_a$ )になる。送信手段3から上部電極46に駆動信号が供給されると、電気機械結合係数( $S_a$ )に基づいた強度の超音波が膜体44から射出される。

50

## 【0039】

また、振動要素28の上部電極46及び下部電極48に、別の直流のバイアス電圧(Vb)が印加されると、バイアス電圧(Vb)により電界が発生する。発生した電界により膜体44に張力が発生して所定の電気機械結合係数(Sb)になる。送信手段3から上部電極46に駆動信号が供給されると、電気機械結合係数(Sb)に基づいた強度の超音波が膜体44から射出される。

ここで、バイアス電圧が「 $V_a < V_b$ 」の場合には、電気機械結合係数は「 $S_a < S_b$ 」となる。

。

## 【0040】

一方、超音波を受波する場合には、被検体から発生した反射エコー信号により膜体44が励起されて内部空間50の容量が変化する。この内部空間50の変化の量が、電気信号として上部電極46を介して検出される。 10

## 【0041】

尚、振動要素28の電気機械結合係数は、膜体44に負荷される張力により決定される。従って、振動要素28に印加するバイアス電圧の大きさを変えて膜体44の張力を制御すれば、同一振幅の駆動信号が入力される場合であっても、振動要素28から射出される超音波の強度(あるいは音圧、振幅)を変化させることができる。

## 【実施例1】

## 【0042】

次に、図5及び図6を参照しながら、本発明の実施例1について説明する。

## 【0043】

20

図5は、実施例1に係る超音波探触子2を示す図である。図5は、図2の超音波探触子2の平面A断面図である。

図5によれば、音響レンズ26の背面に、絶縁層である絶縁膜78が形成される。絶縁膜78は、例えば、シリコン酸化物膜、パラキシリレン膜である。

## 【0044】

cMUTチップ20は、接着層70を介してバッキング層22の上面に接着される。バッキング層22の上面周縁から四方側面に渡って、フレキシブル基板72(Flexible printed circuits:FPC)が設けられる。フレキシブル基板72は、接着層71を介してバッキング層22の上面周縁に接着される。

## 【0045】

30

接着層70及び接着層71は、例えば、エポキシ樹脂からなる接着剤である。接着層70及び接着層71の層厚を任意に調整して、cMUTチップ20及びフレキシブル基板72の高さ方向位置を調整することができる。

## 【0046】

フレキシブル基板72とcMUTチップ20とは、ワイヤ86を介して電氣的に接続される。ワイヤ86は、ワイヤボンディング方式により接続される。ワイヤ86としては、Auワイヤ等を用いることができる。ワイヤ86の周囲には、ワイヤ封止樹脂88が充填される。

## 【0047】

音響レンズ26は、接着層90を介してcMUTチップ20の上面に接着される。音響レンズ26の材質としては、例えば、シリコンゴムが用いられる。接着層90の材質に関しては、音響レンズ26と類似の材質(例えば、シリコン)とすることが望ましい。 40

## 【0048】

音響レンズ26の上面は、超音波が射出される領域である少なくとも領域23の範囲内において、超音波照射方向に凸状である。cMUTチップ20には、少なくとも領域23に対応する範囲内に、振動要素28が配置される。音響レンズ26の超音波射出側(被検体側に)凸状の部分から超音波が照射される。

## 【0049】

音響レンズ26の背面(被検体の配置される方向と反対側、バッキング層側)は、cMUTチップ20がその中に配置されるように凹部を有している。この凹部には、cMUTチップ20とフレキシブル基板72との接続部分(ワイヤ防止樹脂88)が嵌合される。 50

## 【0050】

超音波探触子カバー25は、超音波探触子2の四方側面に設けられる。超音波探触子カバー25は、音響レンズ26の四方側面に固定される。検者は、超音波探触子カバー25を手で把持して超音波探触子2を操作する。

## 【0051】

図6は、超音波探触子2の配線を示す図である。

cMUTチップ20の基板40は、バッキング層22の上面に固定される。フレキシブル基板72は、バッキング層22の上面周縁に固定される。

## 【0052】

フレキシブル基板72には、紙面上下で対になる信号パターン38-1～信号パターン38-n及び紙面左右で対になる信号パターン41-1～信号パターン41-4が配設される。 10

## 【0053】

上部電極46-1～上部電極46-nは、信号パターン38-1～信号パターン38-nに接続される。下部電極48-1～下部電極48-4は、信号パターン41-1～信号パターン41-4に接続される。隣接する下部電極48-1～下部電極48-4間は互いに、絶縁される。

## 【0054】

上部電極46及び下部電極48は、それぞれ、ワイヤ86を介してワイヤボンディング方式によりフレキシブル基板72に接続される。

## 【0055】

尚、下部電極48-1～下部電極48-4の形状は、振動要素28の形状(例えば、六角形)に応じた形状(例えば、波形)とすることが望ましい。これにより、各振動要素28を下部共通電極48-1～下部共通電極48-4のいずれかのみに対応させて配置することができる。 20

## 【0056】

また、下部電極48-1～下部電極48-4が4個配設されるが、数はこれに限られない。

## 【0057】

また、信号パターン38-1～信号パターン38-nは紙面上下に対にして設けられ、信号パターン48-1～信号パターン48-4は紙面左右に対にして設けられるものとして説明したが、これに限られず、対にせず片方だけでもよい。

## 【0058】

また、信号パターンと上部電極又は下部電極とがワイヤボンディング方式により接続されるものとして説明したが、これに限られず、パッド同士で接続するフリップチップボンディング方式を用いてもよい。 30

## 【0059】

以上詳細に説明したように、実施例1の超音波探触子2では、音響レンズとcMUTチップとの間に、cMUTチップ内の電極から被検体へ電気が漏洩するのを防止するための電気漏洩防止手段である絶縁層が絶縁膜78として形成される。超音波送受信面とcMUTチップとの間は、音響レンズ及び絶縁層により二重絶縁される。これにより、超音波送受信面の摩耗や破損等が生じてても超音波送受信面から被検体へ電気が漏洩して感電することがなく、超音波探触子の安全性が向上する。

## 【実施例2】

40

## 【0060】

次に、図7を参照しながら、実施例2について説明する。

図7は、実施例2に係る超音波探触子2aを示す図である。図7は、図2の平面A断面図に相当する。

## 【0061】

実施例1では、絶縁膜78は、音響レンズ26の下面に設けられるものとして説明したが、実施例2では、cMUTチップ内の電極から被検体へ電気が漏洩するのを防止するための電気漏洩防止手段である絶縁層が絶縁膜78aとして、音響レンズ26の上面(被検体側)に設けられる。

## 【0062】

50



このように、実施例2の超音波探触子2aでは、音響レンズの上面に絶縁層が形成される。超音波送受信面とcMUTチップとの間は、絶縁層(絶縁膜)及び音響レンズにより二重絶縁される。従って、実施例1と同様の効果、すなわち、超音波送受信面の摩耗や破損等が生じて超音波送受信面から被検体へ電気が漏洩して感電することがなく、超音波探触子の安全性が向上するという効果が得られる。

【0063】

尚、実施例2では、絶縁層は音響レンズの下面ではなく上面に設けられるので、実施例1と比較して製作が容易である。

【実施例3】

【0064】

10

次に、図8を参照しながら、実施例3について説明する。

図8は、実施例3に係る超音波探触子2bを示す図である。図8は、図2の平面A断面図に相当する。

【0065】

実施例1では、絶縁膜78は、音響レンズ26の下面に設けられるものとして説明したが、実施例3では、cMUTチップ内の電極から被検体へ電気が漏洩するのを防止するための電気漏洩防止手段である絶縁層が絶縁膜78bとして、cMUTチップ20の上面に設けられる。

【0066】

このように、実施例3の超音波探触子2bでは、cMUTチップの上面に絶縁層が形成される。超音波送受信面とcMUTチップとの間は、絶縁層及び音響レンズにより二重絶縁される。従って、実施例1と同様の効果を奏する。

20

【実施例4】

【0067】

次に、図9及び図10を参照しながら、実施例4について説明する。

図9は、実施例4に係る超音波探触子2cを示す図である。図9は、図2の平面A断面図に相当する。

【0068】

実施例1では、グランド層が設けられないものとして説明したが、実施例4では、絶縁層としての絶縁膜78の背面(被検体側と反対側)にcMUTチップ内の電極から被検体へ電気が漏洩するのを防止するための電気漏洩防止手段として更に、グランド層である導電膜76が設けられる。

30

【0069】

導電膜76は、グランド電位であるグランド108に接続される。導電膜76は、例えば、Cu膜である。音響レンズ26の背面に絶縁膜78が設けられ、絶縁膜78の背面にCu膜を蒸着させて導電膜76が形成される。

【0070】

導電膜76は、音響レンズ26の内部下面からの外部側面に渡って形成される。導電膜76は、導電材80及びグランド線84を介して、本体装置側のグランド108に接続される。

【0071】

導電材80は、導電性を有する部材である。導電材80は、導電膜76と比較して破損しにくい信頼度の高い部材で製作することができる。導電材80は、例えば、導電膜76より高剛性のCuテープである。導電材80は、フレキシブル基板72の外部側面に固定される。

40

グランド線84は、半田付け等により接続部82を介して導電材80に接続される。

【0072】

図10は、導電構造及び絶縁構造を示す模式図である。

上部電極46は、ケーブル96及び送受分離回路98を介して受信アンプ100及び送信手段3に接続される。下部電極48は、ケーブル102を介してバイアス手段4に接続される。

抵抗110は、バイアス手段4の電位をグランド電位に安定化させる抵抗素子である。コンデンサ112は、信号電流のバイパス用の容量素子である。

導電膜76は、グランド線84が接続され、さらに、本体装置のシャーシグランドを介して

50

グランド108に接続される。

【0073】

このように、実施例4の超音波探触子2cでは、絶縁層としての絶縁膜78の下方にグランド層としての導電膜76が設けられる。これにより、音響レンズ26及び絶縁膜78が破損した場合でも導電膜76がグランド電位のために感電を防止し、被検体に対する超音波探触子の電気的安全性を向上させることができる。

【0074】

また、導電膜76及びグランド線84及び本体装置のシャーシグランドにより、グランド電位の閉空間が形成される。すなわち、超音波探触子2cの主要構成要素や超音波診断装置の本体回路は、グランド電位の閉空間に内包されるので、外部からの不要電波の影響を受けたり、超音波探触子2c自身が発生する電磁波により外部装置に悪影響を及ぼすこと防止することができる。

【0075】

また、実施例4の超音波探触子2cでは、導電膜76は、音響レンズ26の内部下面から外部側面に渡って形成され、高信頼度の導電材80及びグランド線84を介してグランド108に接続される。

【0076】

これにより、インモールド成形で引き出すシート状の導電膜ではなく、音響レンズ内部下面から外部側面に渡って形成された導電膜から導電材を介してグランド線と容易かつ確実に接続することができる。

そのため、実装の確実性及び作業性を向上させることができる。

【0077】

また、高信頼度の導電材を用いることにより、フレキシブル基板に固定した際に導電材が破損することを防止することができる。

【0078】

また、図9では、フレキシブル基板72の紙面左側側面のみに導電材80及びグランド線84を図示したが、フレキシブル基板72の四方側面の少なくともいずれかに設けてもよい。

【0079】

尚、導電膜76とグランド線84とを直接接続してもよい。この場合は、導電膜76は膜厚が薄いので、実装作業を慎重に行う必要がある。

【0080】

本実施例では、グランド層が絶縁膜78の背面(被検体側と反対側)に設けられているが、該グランド層とcMUTチップ内の電極(例えば図4における電極46)の間には電気を導通しない介在層が、cMUTチップの一部に図4における膜体44として配置されている。そのため、cMUTチップ内の電極(例えば図4における電極46)とグランド層が特許文献2のように接していないので、超音波送受信のための駆動電圧をcMUTチップ内の超音波送受信側(被検体側)の電極へも印加できるという利点もある。

【実施例5】

【0081】

次に、図11を参照しながら、実施例5について説明する。

図11は、実施例5に係る超音波探触子2dを示す図である。図11は、図2の平面A断面図に相当する。

【0082】

実施例4では、導電材80は、フレキシブル基板72の外部側面に固定されるものとして説明したが、これに限られず、導電材80を固定可能な部材であれば固定先は限定されない。実施例5では、導電材80dは、超音波探触子カバー25の内部側面に固定される。

【0083】

導電膜76は、導電材80d及びグランド線84dを介して、本体装置側のグランド108に接続される。

導電材80dは、超音波探触子カバー25の内部側面に固定される。グランド線84dは、半田

付け等により接続部82dを介して導電材80dに接続される。

これにより、実施例5では、実施例4と同様に、高信頼度を確保しつつ導電膜とグランド線とを容易かつ確実に接続することができる。

【0084】

尚、図11では、超音波探触子カバー25の紙面左側内部側面のみに導電材80d及びグランド線84dを図示したが、超音波探触子カバー25の四方内部側面の少なくともいずれかに設けてもよい。

【実施例6】

【0085】

次に、図12を参照しながら、実施例6について説明する。

10

図12は、実施例6に係る超音波探触子2eを示す図である。図12は、図2の平面A断面図に相当する。

【0086】

実施例1～実施例5では、1層の絶縁層が設けられるものとして説明したが、第6の実施形態では、グランド層を挟んで2層の絶縁層が設けられる。

【0087】

音響レンズ26とcMUTチップ20上の接着層90との間には、上部絶縁層としての絶縁膜78及びグランド層としての導電膜76及び下部絶縁層としての絶縁膜74が形成される。導電膜76は、絶縁膜78と絶縁膜74との間に形成される。

【0088】

20

すなわち、超音波探触子2の被検体に接触される方向から音響レンズ26及び絶縁膜78及び導電膜76及び絶縁膜74の順で積層される。詳細には、音響レンズ26下面に絶縁膜78が形成され、絶縁膜78の下面にCu膜を蒸着させて導電膜76が形成され、導電膜76の下面に絶縁膜74が形成される。

【0089】

このように、実施例6では、超音波送受信面とcMUTチップとの間には、音響レンズ及び、cMUTチップ内の電極から被検体へ電気が漏洩するのを防止するための電気漏洩防止手段としての導電膜を間に挟んだ2層の絶縁層が備えられている。これにより、超音波探触子の絶縁性を高めて安全性を向上させることができる。

【0090】

30

また本実施例では、グランド層が2層の絶縁膜74と78の間に設けられているが、該グランド層とcMUTチップ内の電極(例えば図4における電極46)の間には電気を導通しない介在層として更に、絶縁膜74が配置されている。そのため、cMUTチップ内の電極(例えば図4における電極46)とグランド層が特許文献2のように接していないので、超音波送受信のための駆動電圧をcMUTチップ内の超音波送受信面側(被検体側)の電極へも印加できるという利点がある。

【実施例7】

【0091】

次に、図13を参照しながら、実施例7について説明する。

図13は、実施例7に係る超音波探触子2fを示す図である。図13は、図2の平面A断面図に相当する。

40

【0092】

実施例6では、絶縁膜74は、領域23で示された領域に設けられるものとして説明したが、第7の実施形態では、絶縁膜74fは、領域23の範囲には設けられない。

【0093】

このように、実施例7では、cMUTチップ20上に絶縁膜74fが存在せず、絶縁膜74fがcMUTチップ20において送受される超音波に影響を及ぼすことがない。従って、音響特性を向上させることができる。

【0094】

上述の実施例では、導電層の膜厚を0.1 $\mu$ m程度とし、絶縁層の膜厚を1 $\mu$ m程度とする

50

ことが望ましい。絶縁層及び導電層の膜厚をそれぞれ薄くすることにより、cMUTチップにおいて送受される超音波への影響(パルス・周波数特性への影響や減衰)を抑制することができる。

【0095】

膜形成方法に関しては、音響レンズの成形と同時に導電膜付絶縁シートをインモールド成形する方法や絶縁膜及び導電膜を物理的蒸着あるいは化学的蒸着により形成する方法がある。インモールド成形では、低コストに膜を形成することができるが、膜厚 $10\mu\text{m}$ 程度が限界である。一方、蒸着による膜形成では、膜厚 $1\mu\text{m}$ 程度とすることができる。

【0096】

本実施例において、領域23において絶縁膜が設けられない領域は74fであったが、78で 10  
も良いし、両方でも良い。

【0097】

尚、上述の実施形態を適宜組み合わせて超音波探触子及び超音波診断装置を構成するようにしてもよい。

【実施例8】

【0098】

図14は、実施例8に係る超音波探触子2gを示す図である。

超音波探触子2gは、音響レンズ26の下面にグラウンド層76gが設けられ、更に絶縁層78gが 20  
音響レンズ26の上面(被検体側)に設けられ、絶縁膜74gがグラウンド層76gの背面に設けられている。

【実施例9】

【0099】

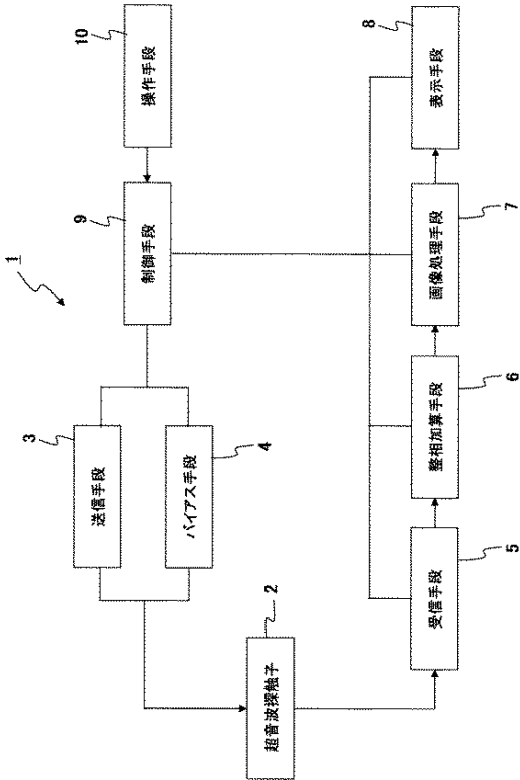
図15は、実施例9に係る超音波探触子2hを示す図である。

超音波探触子2hは、cMUTチップ内の電極から被検体へ電気が漏洩するのを防止するための電気漏洩防止手段として導電膜を間に挟んだ2層の絶縁層が備えられている場合であるが、導電膜76hとグラウンド線84を結ぶための導電材80が、フレキシブル基板72に固定されている例である。

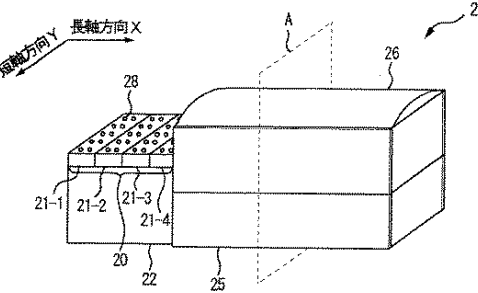
【0100】

以上、添付図面を参照しながら、本発明に係る超音波探触子及び超音波診断装置の好適な実施形態について説明したが、本発明はかかる例に限定されない。当業者であれば、本 30  
願で開示した技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものである。

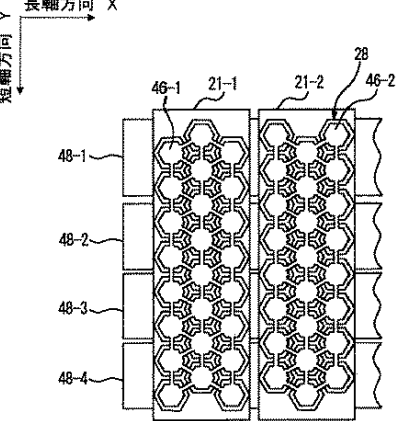
【図 1】



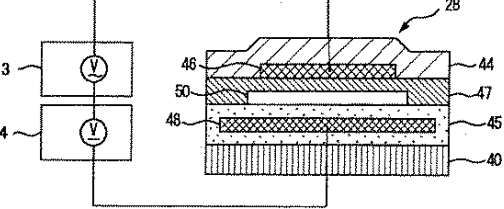
【図 2】



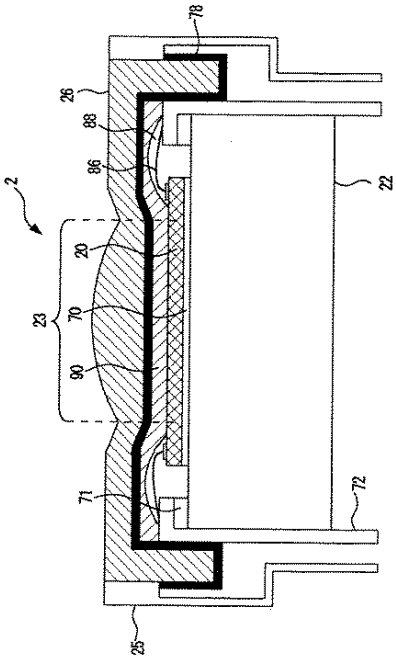
【図 3】



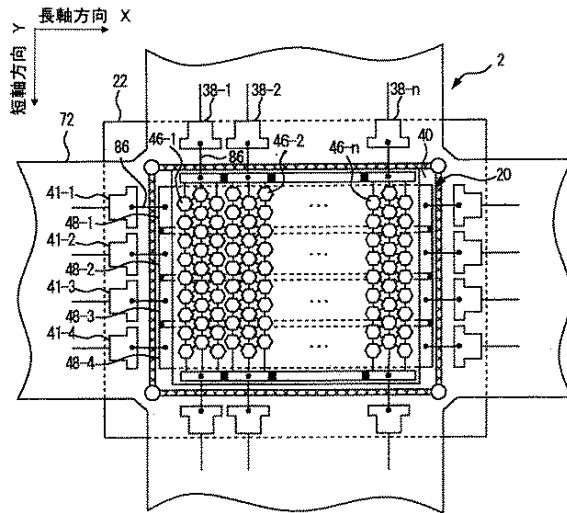
【図 4】



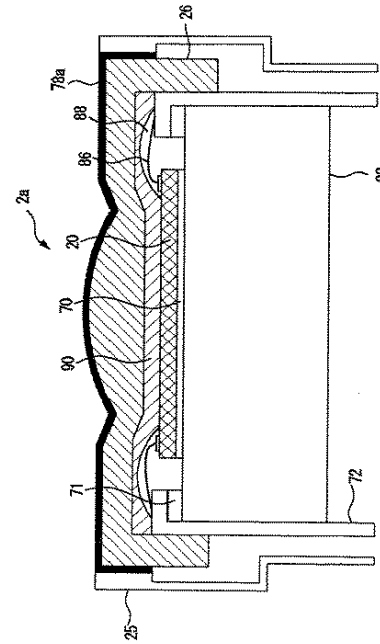
【図 5】



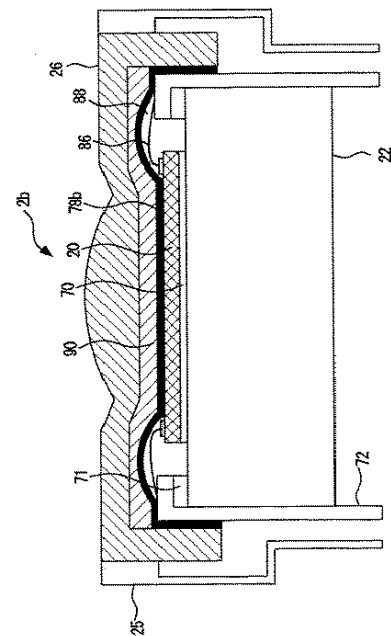
【図 6】



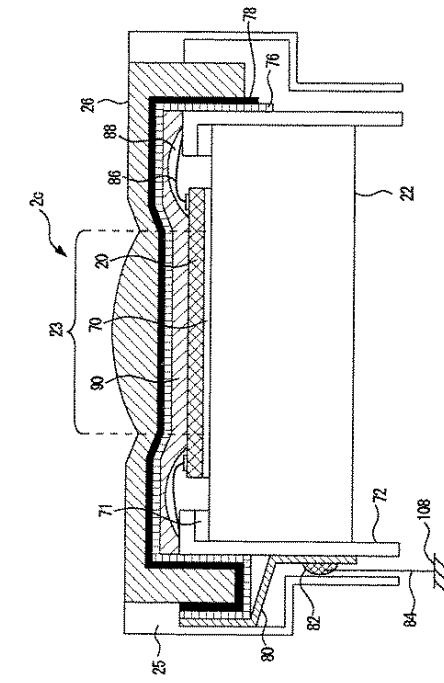
【図 7】



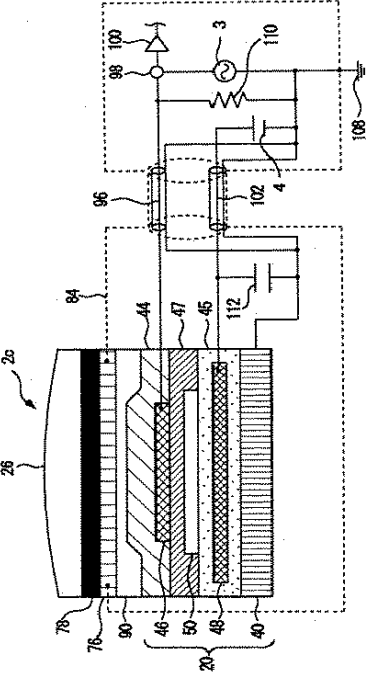
【図 8】



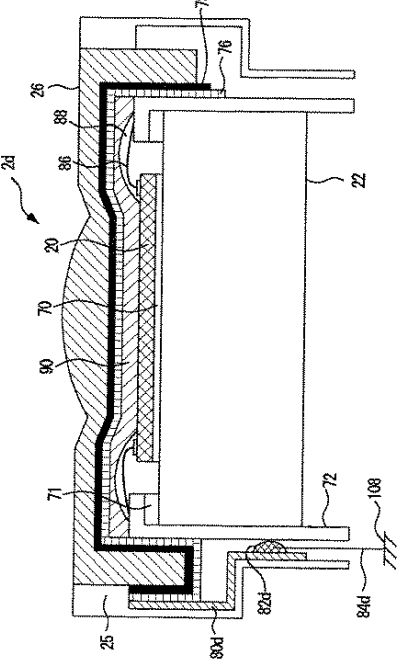
【図 9】



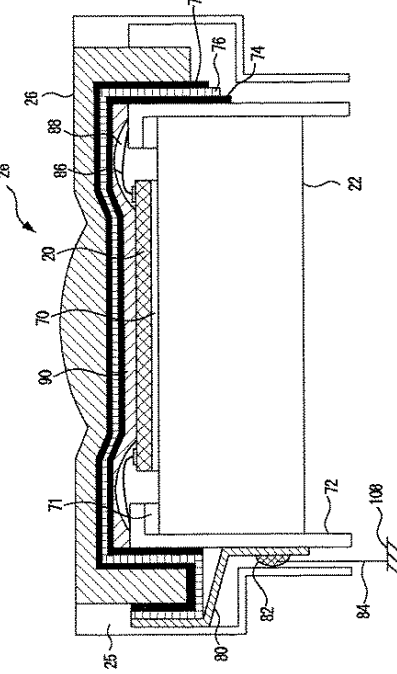
【図 1 0】



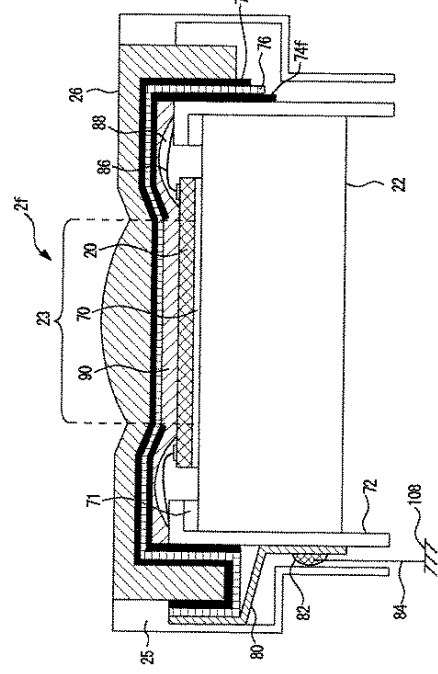
【図 1 1】



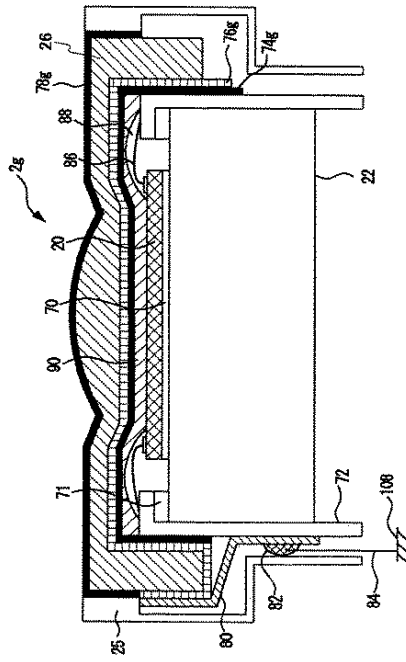
【図 1 2】



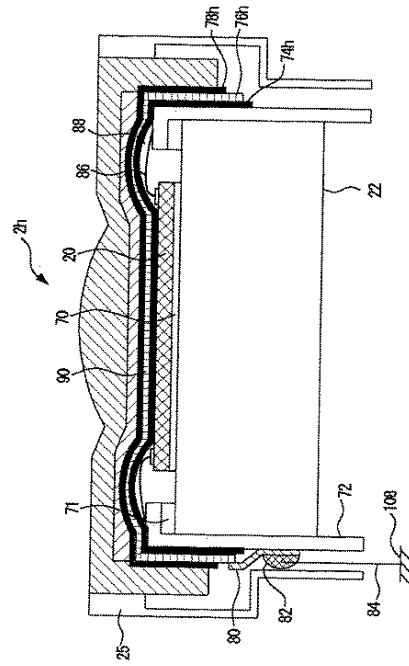
【図 1 3】



【例 14】



【图 15】





## 【国際調査報告】

<b>INTERNATIONAL SEARCH REPORT</b>		International application No. <b>PCT/JP2007/071516</b>
<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> <b>H04R19/00(2006.01)i, A61B8/00(2006.01)i</b>		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b>		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) <b>H04R19/00, A61B8/00</b>		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2008 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2008 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2008		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 2006-166985 A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 29 June, 2006 (29.06.06), Par. Nos. [0052] to [0055]; Figs. 11 to 14 & US 2006/0184035 A1	1, 2, 9, 10, 16 8
Y	JP 06-205772 A (Toshiba Corp.), 25 July, 1994 (25.07.94), Par. Nos. [0027] to [0036]; Fig. 3 (Family: none)	8
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 19 February, 2008 (19.02.08)		Date of mailing of the international search report 04 March, 2008 (04.03.08)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2007/071516

**Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)**

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:  
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
  
2. ☐ Claims Nos.:  
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
  
3. ☐ Claims Nos.:  
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

**Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)**

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

Because of the reason given below, the international application includes two groups of inventions which do not satisfy the requirement of unity of invention.

First group of inventions: claims 1, 2, 8-10, and 16

Second group of inventions: claims 3-7, 11-15, and 17

(Continued to extra sheet)

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
  
4. ☒ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: 1, 2, 8-10, and 16

**Remark on Protest**  
the

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, payment of a protest fee.
- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- ☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2007/071516

Continuation of Box No.III of continuation of first sheet (2)

The search was made on claims 1, 2, 8 as "the first (main) group of inventions". However, the search has revealed that the technical feature of claims 1 and 2 is not novel since it is disclosed as a prior art in Document 1: JP 2006-166985 A (Fuji Photo Film Co., Ltd.), 29 June, 2006 (29.06.06), [0052]-[0055], Figs. 11-14.

The "CMUT chip" in claim 1 is disclosed as the "electrostatic oscillator" produced in the semiconductor manufacturing process in Document 1. The "acoustic lens" in claim 1 is disclosed as the "acoustic lens" in Document 1. The "backing layer" in claim 1 is disclosed as the "backing member" of Document 1. The "insulating layer" in claim 2 is disclosed as "the protection insulating layer" in Document 1.

Accordingly, the technical feature of claims 1 and 2 cannot be "a special technical feature" within the meaning of PCT Rule 13.2, second sentence.

When claim 8 is compared to the aforementioned prior art, the "(temporary) special technical feature" of the first group of inventions is that "the insulating layer is arranged on the ultrasonic transmission/reception surface of the acoustic lens".

Moreover, when claim 11 (second group of invention) is compared to the aforementioned prior art technique, the "(temporary) special technical feature" of the second group of inventions is that "at least one ground layer is provided at the side of the insulating layer opposite to the examinee side".

Consequently, there is no technical relationship between the first and the second group of inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features.

It should be noted that the inventions of claims 9, 10, 16 are equivalent to the invention of claim 2 added by a conventional technique and accordingly, they are classified into the same group as claim 2. Moreover, the inventions of claims 3-7, 12-15, 17 have the same special technical feature as claim 11 and accordingly, they are classified into the same group as claim 11.

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 7 / 0 7 1 5 1 6	
A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C）） Int.Cl. H04R19/00(2006.01)i, A61B8/00(2006.01)i			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C）） Int.Cl. H04R19/00, A61B8/00			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2008年 日本国実用新案登録公報 1996-2008年 日本国登録実用新案公報 1994-2008年			
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X Y	JP 2006-166985 A（富士写真フイルム株式会社）2006.06.29, 【0052】－【0055】及び第11-14図 & US 2006/0184035 A1	1, 2, 9, 10, 16 8	
Y	JP 06-205772 A（株式会社東芝）1994.07.25, 【0027】－【0036】及び第3図（ファミリーなし）	8	
<input type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 19.02.2008		国際調査報告の発送日 04.03.2008	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁（I S A / J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官（権限のある職員） 大野 弘 電話番号 03-3581-1101 内線 3541	

様式PCT/I S A / 2 1 0（第2ページ）（2007年4月）

国際調査報告	国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 7 / 0 7 1 5 1 6
第Ⅱ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見（第1ページの2の続き）	
<p>法第8条第3項（PCT17条(2)(a)）の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。</p> <p>1. <input type="checkbox"/> 請求の範囲 _____ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。つまり、</p> <p>2. <input type="checkbox"/> 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、</p> <p>3. <input type="checkbox"/> 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。</p>	
第Ⅲ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見（第1ページの3の続き）	
<p>次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。</p> <p>以下の理由により、この国際出願は発明の単一性の要件を満たさない2つの発明を含む。</p> <p>主発明：請求の範囲1，2，8－10及び16</p> <p>第2発明：請求の範囲3－7，11－15及び17</p> <p>請求の範囲1，2及び8を「最初に記載されている発明（「主発明」）」として調査を行った結果、請求の範囲1及び2の技術的特徴は、先行技術として、文献1：JP 2006-166985 A（富士写真フイルム株式会社）2006.06.29，【0052】－【0055】及び第11－14図に開示されているから新規でないことが明らかとなった。</p> <p>1. <input type="checkbox"/> 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。</p> <p>2. <input type="checkbox"/> 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。</p> <p>3. <input type="checkbox"/> 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。</p> <p>4. <input checked="" type="checkbox"/> 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。</p> <p style="padding-left: 40px;">請求の範囲1，2，8－10及び16</p> <p>追加調査手数料の異議の申立てに関する注意</p> <p><input type="checkbox"/> 追加調査手数料及び、該当する場合には、異議申立手数料の納付と共に、出願人から異議申立てがあった。</p> <p><input type="checkbox"/> 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあったが、異議申立手数料が納付命令書に示した期間内に支払われなかった。</p> <p><input type="checkbox"/> 追加調査手数料の納付はあったが、異議申立てはなかった。</p>	

## &lt;第Ⅲ欄の続き&gt;

請求の範囲1における「cMUT チップ」は、文献1の「静電容量型振動子」が半導体製造工程で作成されることとして開示されている。請求の範囲1における「音響レンズ」は、文献1の「音響レンズ」として開示されている。請求の範囲1における「パッキング層」は、文献1の「パッキング材」として開示されている。請求の範囲2における「絶縁層」は、文献1の「保護絶縁層」として開示されている。

したがって、請求の範囲1及び2の技術的特徴は、PCT 規則 13.2 の第2文の意味において「特別な技術的特徴」とは認められない。

そして、請求の範囲8と上記先行技術とを比較する限りにおいて、主発明の「(当座の) 特別な技術的特徴」は「前記絶縁層が前記音響レンズの超音波送受信面に備えられていること」である。

また、請求の範囲11(第2発明)と上記先行技術とを比較する限りにおいて、第2発明の「(当座の) 特別な技術的特徴」は「少なくとも1層のグランド層が、前記絶縁層の前記被検体側と反対側に備えられていること」である。

よって、これら主発明と第2発明の間に一又は二以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係が存在するとは認められない。

なお、請求の範囲9、10及び16は、請求の範囲2に周知技術を付加したにすぎないため、請求の範囲2と同じ発明区分とした。また請求の範囲3-7、12-15及び17は、請求の範囲11と同一の特別な技術的特徴を有するので、請求の範囲11と同じ発明区分とした。

## フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

Fターム(参考) 4C601 EE16 GB06 GB50  
5D019 EE01 FF04 GG03 GG06

(注) この公表は、国際事務局（W I P O）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	超声波探头和使用其的超声波诊断装置		
公开(公告)号	<a href="#">JPWO2008056643A1</a>	公开(公告)日	2010-02-25
申请号	JP2008543071	申请日	2007-11-06
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日立医药		
申请(专利权)人(译)	株式会社日立メディコ		
[标]发明人	佐野秀造 佐光暁史 小林隆 泉美喜雄		
发明人	佐野 秀造 佐光 暁史 小林 隆 泉 美喜雄		
IPC分类号	A61B8/00 H04R17/00		
CPC分类号	A61B8/4281 A61B8/4455 A61B8/4483 B06B1/0292 H04R19/005		
FI分类号	A61B8/00 H04R17/00.330.G		
F-TERM分类号	4C601/EE16 4C601/GB06 4C601/GB50 5D019/EE01 5D019/FF04 5D019/GG03 5D019/GG06		
优先权	2006302627 2006-11-08 JP		
其他公开文献	JP5009301B2		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

#### 摘要(译)

一种具有多个振动元件的cMUT芯片，该振动元件的机电耦合系数或灵敏度根据偏置电压而变化，并且发送和接收超声波，该声学元件设置在cMUT芯片上方和cMUT芯片下方 在具有背衬层的超声波探头中 防漏电装置设置在声透镜的超声波发送/接收表面侧上或在声透镜与cMUT芯片之间。防漏电装置例如是绝缘层，例如接地层。具有这样的结构的超声波探头以及使用该超声波探头的超声波诊断装置，能够防止从超声波探头向被检体的漏电并提高电气安全性。可以提供。

